

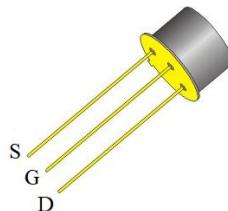


## LYNM210G 大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管

### 1、特性

LYNM210G 型大功率 N 沟道 MOS 场效应晶体管具有开关速度快、损耗小、输入阻抗高、驱动功耗小安全工作区宽、温度稳定性好等优点。该产品为单极型的电压控制器件，在电子线路中主要起开关或放大功能。

器件采用 A3-02B 型金属封装，静电放电敏感度为 500V，A3-02B 典型重量 1.13g。



A3-02B 型

### 2、质量等级及执行标准

G、G+:Q/RBJ1005QZ, QJZ840611;

JCT/K, JCT/K+ (A3-02B): Q/RBJ22032H1-2016, GJB33A-1997;

### 3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	$P_D^a$ $T_C=25^\circ\text{C}$ W	$V_{GS}$ V	$I_{DM1}$ $T_C=25^\circ\text{C}$ A	$I_{DM2}$ $T_C=100^\circ\text{C}$ A	$T_{jM}$ °C	$T_{stg}$ °C	$R_{(th)J-A}$ °C/W
LYNM210G	15	$\pm 20$	2.25	1.5	150	-55~150	180

<sup>a</sup>  $T_C > 25^\circ\text{C}$  时，按 0.12W/°C 线性降额。

### 4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

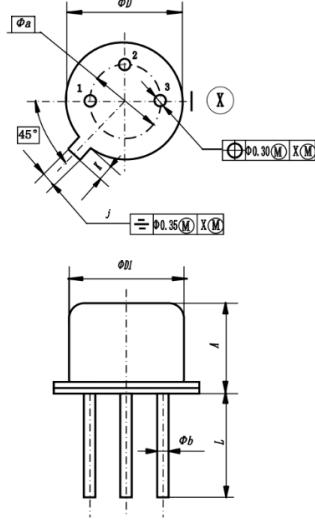


# MOS 场效应晶体管系列产品

表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=I_{DM2}$	—	—	1.5	$\Omega$
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=1.0mA$	200	—	—	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=0.25mA$	2.0	—	4.0	V
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}, V_{GS}=0V$	—	—	25	$\mu A$
正向栅极漏电流	$I_{GSSF}$	$V_{GS}=20V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS}=-20V$	—	—	-100	nA
开启延迟时间	$t_{d(ON)}$	$V_{DD}=100V, V_{GS}=10V, I_D=1.5A, R_G=7.5\Omega$	—	45	—	ns
上升时间	$t_r$		—	75	—	ns
关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	75	—	ns
下降时间	$t_f$		—	60	—	ns
电容	$C_{ISS}$	$V_{DS}=100V, I_D=5.5A, V_{GS}=10V$	—	42.1	—	pF

## 5、外形尺寸



引出端极性: 1-源极 2-栅极 3-漏极

A3-02B 外形尺寸

单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典型值	最 大
$A$	6.10	—	6.80
$\Phi a$	—	5.08	—
$\Phi b$	0.407	—	0.508
$\Phi D$	8.64	—	9.39
$\Phi D_l$	8.01	—	8.50
$j$	0.612	0.787	0.963
$K$	0.40	—	1.14
$L$	12.5	—	25.0

## 6、使用和维护

### 6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大, 在安装、测试等过程中轻拿轻放, 避免碰撞、重物碾压, 否则易造成金属裂缝, 影响其密封性。

焊接安装时, 器件允许耐焊接热的条件是温度 260°C 下不超过 10 秒; 浸锡温度不超过 260°C, 时间不超过 10 秒。

### 6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按规定条件、方法进行, 应使用合格的设备、仪器仪表, 并对其进行校验; 操作人员必须持证上岗, 必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用, 注意防潮、防尘, 严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况, 请与供应商联系。